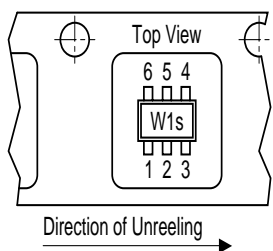


**NPN/PNP Silicon Digital Transistor Array**

- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Two (galvanic) internal isolated NPN/PNP Transistors in one package
- Built in bias resistor NPN and PNP ( $R_1=10\text{ k}\Omega$ ,  $R_2=47\text{ k}\Omega$ )
- Pb-free (ROHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101


**Tape loading orientation**


Marking on SOT-363 package (for example W1s) corresponds to pin 1 of device

Position in tape: pin 1 opposite of feed hole side

EHA07193

Type	Marking	Pin Configuration					Package
		1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	
BCR35PN	WUs						SOT363

**Maximum Ratings for NPN and PNP Types**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	$V_{CEO}$	50	V
Collector-base voltage	$V_{CBO}$	50	
Input forward voltage	$V_{i(fwd)}$	40	
Input reverse voltage	$V_{i(rev)}$	6	
DC collector current	$I_C$	100	mA
Total power dissipation, $T_S = 115\text{ }^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	250	mW
Junction temperature	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-65 ... 150	

**Thermal Resistance**

Junction - soldering point <sup>1)</sup>	$R_{thJS}$	$\leq 140$	K/W
------------------------------------------	------------	------------	-----

<sup>1)</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

**Electrical Characteristics** at  $T_A=25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b> for NPN and PNP Types					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	50	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\ \mu\text{A}, I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	50	-	-	
Collector cutoff current $V_{CB} = 40\ \text{V}, I_E = 0$	$I_{CBO}$	-	-	100	nA
Emitter cutoff current $V_{EB} = 6\ \text{V}, I_C = 0$	$I_{EBO}$	-	-	167	$\mu\text{A}$
DC current gain 1) $I_C = 5\ \text{mA}, V_{CE} = 5\ \text{V}$	$h_{FE}$	70	-	-	-
Collector-emitter saturation voltage1) $I_C = 10\ \text{mA}, I_B = 0.5\ \text{mA}$	$V_{CEsat}$	-	-	0.3	V
Input off voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}, V_{CE} = 5\ \text{V}$	$V_{i(off)}$	0.5	-	1	
Input on Voltage $I_C = 2\ \text{mA}, V_{CE} = 0.3\ \text{V}$	$V_{i(on)}$	0.5	-	1.4	
Input resistor	$R_1$	7	10	13	$\text{k}\Omega$
Resistor ratio	$R_1/R_2$	0.19	0.21	0.24	-
<b>AC Characteristics</b> for NPN and PNP Types					
Transition frequency $I_C = 10\ \text{mA}, V_{CE} = 5\ \text{V}, f = 100\ \text{MHz}$	$f_T$	-	150	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10\ \text{V}, f = 1\ \text{MHz}$	$C_{cb}$	-	2	-	pF

 1) Pulse test:  $t < 300\ \mu\text{s}; D < 2\%$

**NPN Type**

**DC Current Gain  $h_{FE} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



**Collector-Emitter Saturation Voltage**

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$



**Input on Voltage  $V_{i(on)} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 0.3V$  (common emitter configuration)



**Input off voltage  $V_{i(off)} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



**PNP Type**

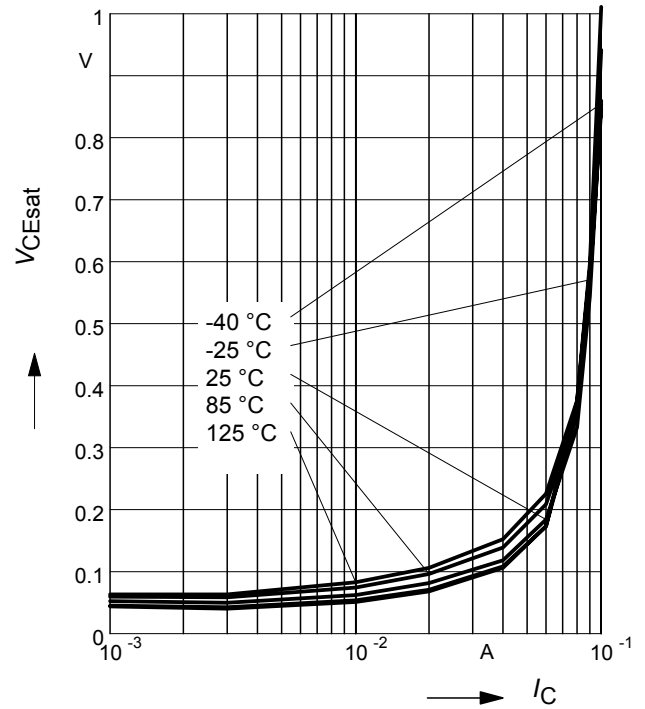
**DC Current Gain  $h_{FE} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



**Collector-Emitter Saturation Voltage**

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$



**Input on Voltage  $V_{i(on)} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 0.3V$  (common emitter configuration)

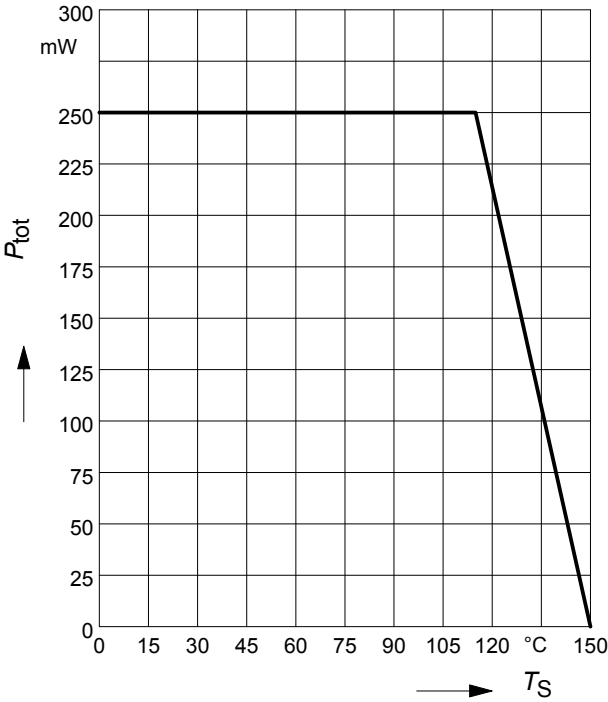


**Input off voltage  $V_{i(off)} = f(I_C)$**

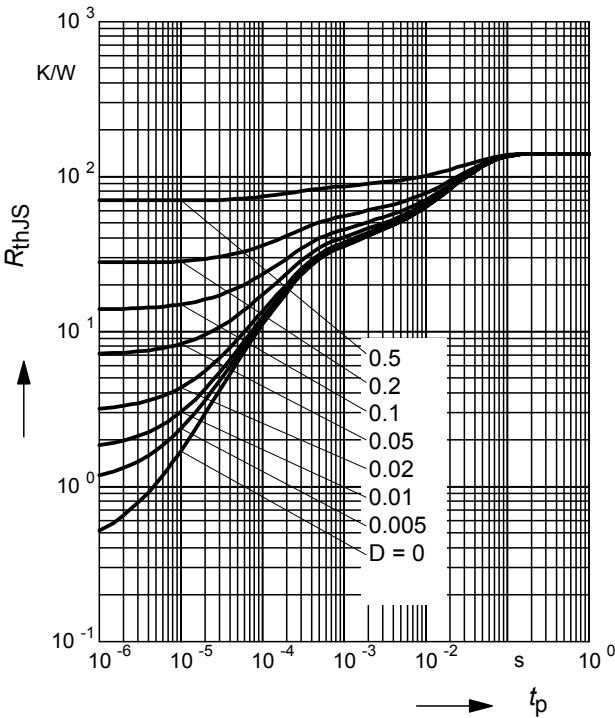
$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



**Total power dissipation  $P_{tot} = f(T_S)$**

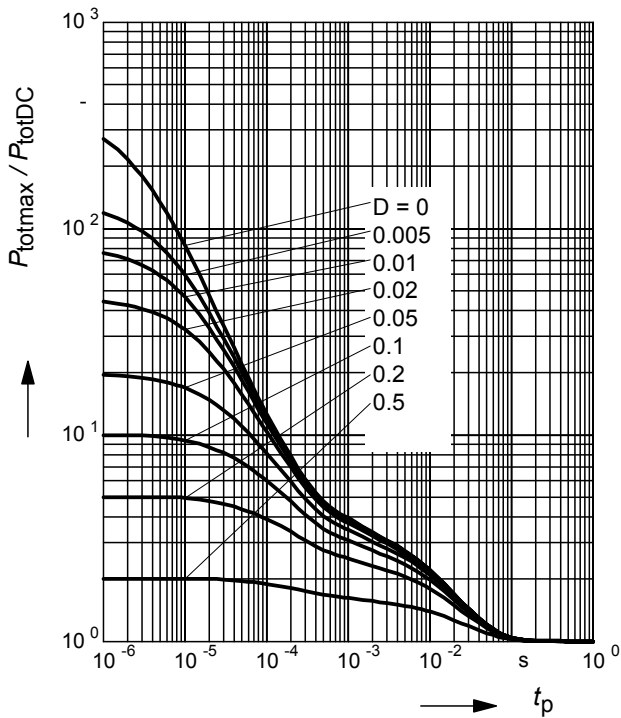


**Permissible Pulse Load  $R_{thJS} = f(t_p)$**



**Permissible Pulse Load**

$P_{totmax} / P_{totDC} = f(t_p)$



Package Outline



Foot Print



Marking Layout (Example)

Small variations in positioning of Date code, Type code and Manufacture are possible.



Standard Packing

Reel  $\varnothing$ 180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing$ 330 mm = 10.000 Pieces/Reel

For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.



**Edition 2009-11-16**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

### **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331